

GaN基第三代半导体材料新兴应用及材料外延

张立胜 总经理 (博士)

时间: 2024年6月6日 (星期四) 13:00—14:30

地点: 北京大学物理楼中312会议室

报告人简介 (About speaker):

张立胜，北京大学博士，北京中博芯半导体科技有限公司总经理，北京市科技新星，长期从事GaN基第三代半导体材料外延和产业化工作。作为主要参与人，在GaN基半导体功率器件、射频器件、深紫外光电器件用材料外延领域取得了多项国内领先、国际先进的产业成果；同时，承担/参与国家/省部级科研项目7项，申请/授权发明专利12件。



摘要 (Abstract):

GaN基第三代半导体是我国新基建和智能制造的核心支撑材料，主要应用于光电子、电力电子和射频电子领域，具体可细分为照明显示、激光器、紫外发光与探测、功率电子器件、射频电子器件等。材料外延是GaN基半导体产业链的基础环节。近年来，随着GaN基半导外延材料质量、掺杂、应力和表界面等问题的解决，它们在深紫外光电材料与器件、功率器件、射频功放器件和滤波器等领域实现了产业化突破，并将迎来万亿规模的蓝海市场。

联系人 (Host): 唐宁 ntang@pku.edu.cn

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

